

Germanium PNP Transistor

GD241

40V / 3A

DATASHEET

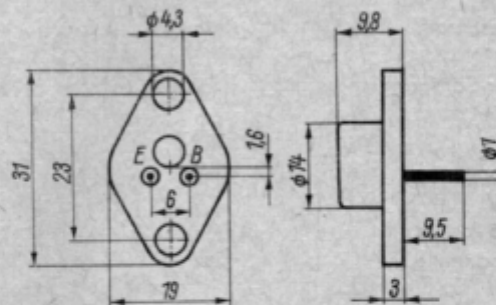
OEM – RFT

Source: RFT Datenbuch Germanium Transistoren 71/72



GD 241, 2-GD 241

Germanium-pnp-Leistungstransistor der Bauform D nach TGL 11 811 für Verstärker-Endstufen und als Paare für Gegentaktstufen im Niederfrequenzgebiet sowie für Schalteranwendungen bis 35 V.



Masse ca. 12 g

Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO}$	= 40 V
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CER}$	= 35 V
$R_{BE} = 50 \Omega$		
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CES}$	= 40 V
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$	= 20 V
Gesamtverlustleistung	P_{VL}	= 10 W
Kollektorstrom	$-I_{CL}$	= 3,0 A
Emitterstrom	$-I_{EL}$	= 3,6 A
Basisstrom	$-I_{BL}$	= 0,6 A
Sperrschichttemperatur	θ_{JL}	= +85 °C
Umgebungstemperatur	θ_{aL}	= -25 °C bis +65 °C
Wärmewiderstand	$R_{th c}$	≤ 4 grd/W




KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Röhrenwerk Anna Seghers Neuhaus

127

GD 241, 2-GD 241		RFT electronic		
Statische Kennwerte		Min.	Typ	Max.
Kollektor-Basis-Reststrom $-U_{CB} = 6\text{ V}$	$-I_{CBO}$		$35\ \mu\text{A}$	$100\ \mu\text{A}$
Kollektor-Emitter-Reststrom $-U_{CE} = 40\text{ V}$	$-I_{CES}$		$0,5\text{ mA}$	$2,5\text{ mA}$
Kollektor-Emitter-Reststrom $-U_{CE} = 30\text{ V}$ $U_{BE} = 1\text{ V}$	$-I_{CEV}$		$0,1\text{ mA}$	1 mA
Emitter-Basis-Reststrom $-U_{EB} = 20\text{ V}$	$-I_{EBO}$		$50\ \mu\text{A}$	$500\ \mu\text{A}$
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung $-I_B = 0,5\text{ A}$ $-I_C = 3\text{ A}$	$-U_{CEsat}$		$0,25\text{ V}$	$0,6\text{ V}$
Basis-Emitter-Spannung $-U_{CE} = 6\text{ V}$ $-I_C = 0,5\text{ A}$	$-U_{BE}$		$0,35\text{ V}$	$0,7\text{ V}$
Basis-Emitter-Spannung $-U_{CE} = 2\text{ V}$ $-I_C = 2\text{ A}$	$-U_{BE}$		$0,75\text{ V}$	$1,4\text{ V}$
Dynamische Kennwerte				
Übergangsfrequenz $-U_{CE} = 6\text{ V}$ $I_C = 0,1\text{ A}$	f_T		350 kHz	
Kurzschlußstromverstärkung $-U_{CE} = 2\text{ V}$ $-I_C = 2\text{ A}$	h_{21E}	18 28 45 68		35 56 90 A B C D
Kurzschlußstromverstärkung $-U_{CE} = 6\text{ V}$ $-I_C = 0,5\text{ A}$	h_{21E}	40		
h_{21E} -Verhältnis $-U_{CE} = 2\text{ V}$ $-I_C = 2\text{ A}$ $-I_C = 0,5\text{ A}$	$\frac{h_{21E\ 2,0}}{h_{21E\ 0,5}}$	$0,5$		

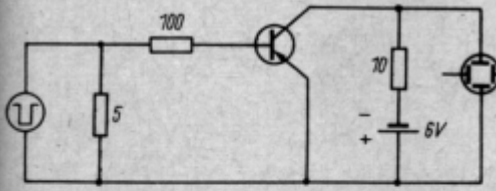


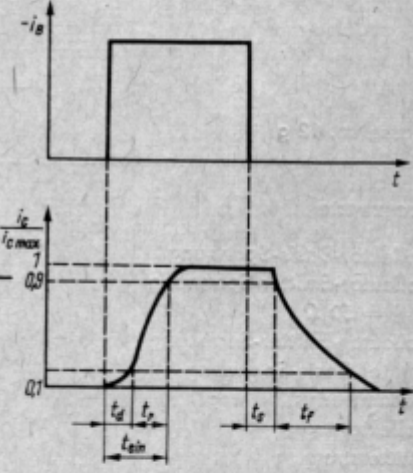


RFT
electronic

GD 241, 2-GD 241

		Min.	Typ	Max.
<p>Pärchenbedingungen</p> <p>$I_{B1} : -U_{CE} = 6\text{ V}$ $-I_C = 0,5\text{ A}$</p> <p>$I_{B2} : -U_{CE} = 2\text{ V}$ $-I_C = 3\text{ A}$</p> <p>$-U_{CE} = 2\text{ V}$ $-I_C = 3\text{ A}$</p>	$\frac{I_{B1}}{I_{B2}}$			1,2
<p>Schaltzeiten Siehe Meßschaltung Übersteuerungsfaktor $m = 3$</p>	<p>t_{on}</p> <p>t_s</p> <p>t_f</p>		<p>$15\ \mu\text{s}$</p> <p>$4\ \mu\text{s}$</p> <p>$4\ \mu\text{s}$</p>	<p>$30\ \mu\text{s}$</p> <p>$8\ \mu\text{s}$</p> <p>$8\ \mu\text{s}$</p>






Bestellbeispiel für einen Transistor der Stromverstärkungsgruppe D

Bestellbeispiel für ein Transistorpaar der Stromverstärkungsgruppe D

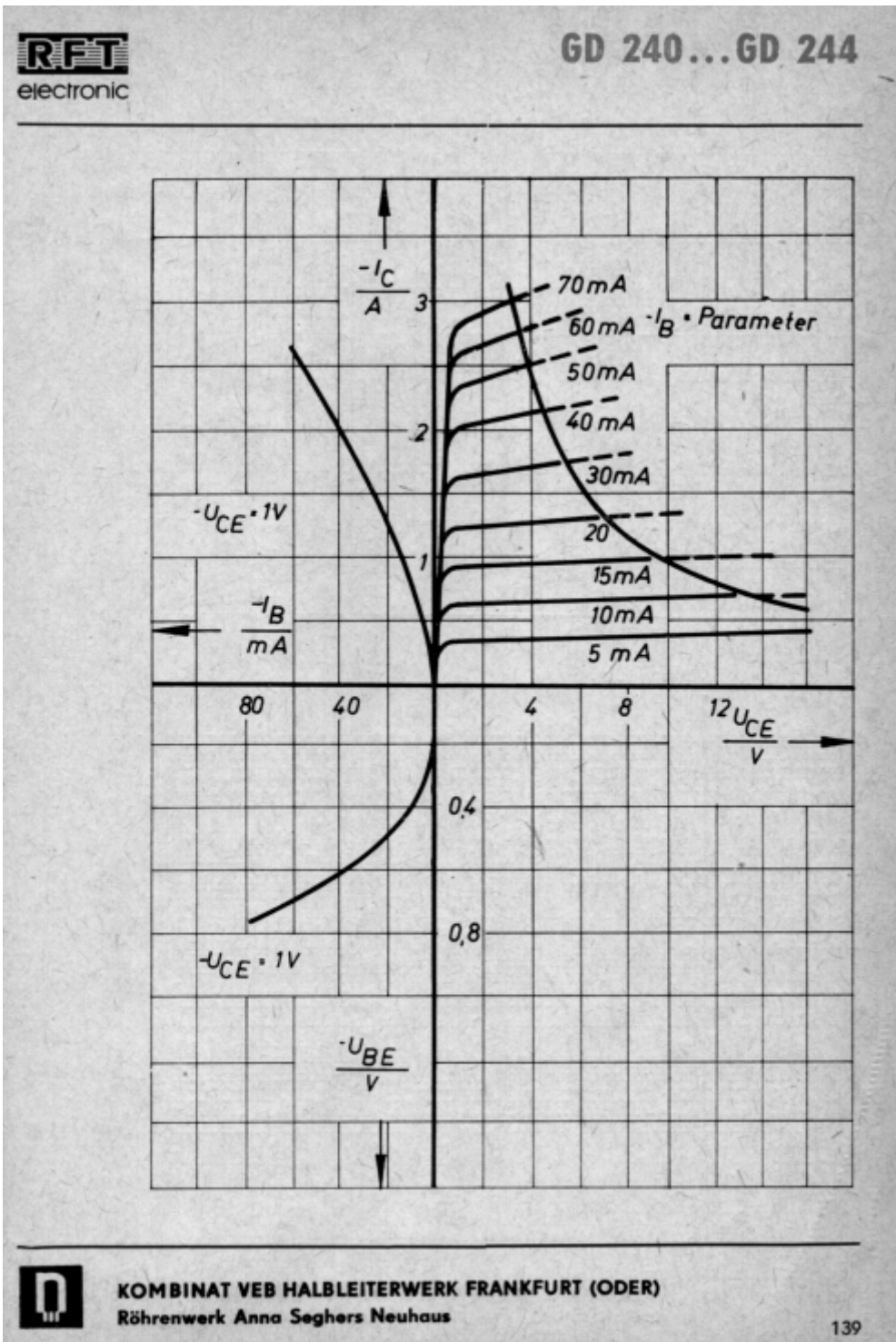
Transistor GD 241 D

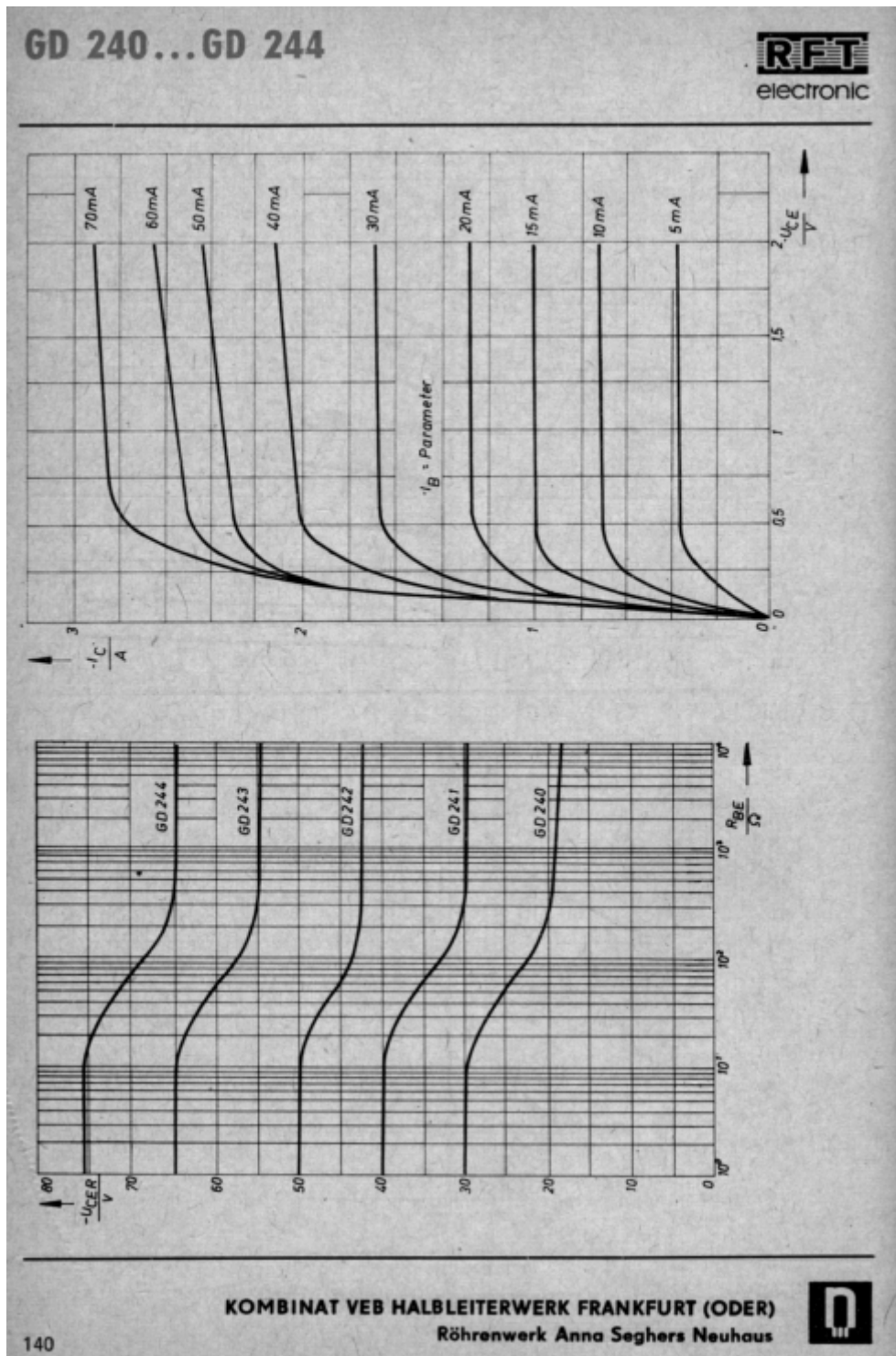
Transistorpaar 2-GD 241 D

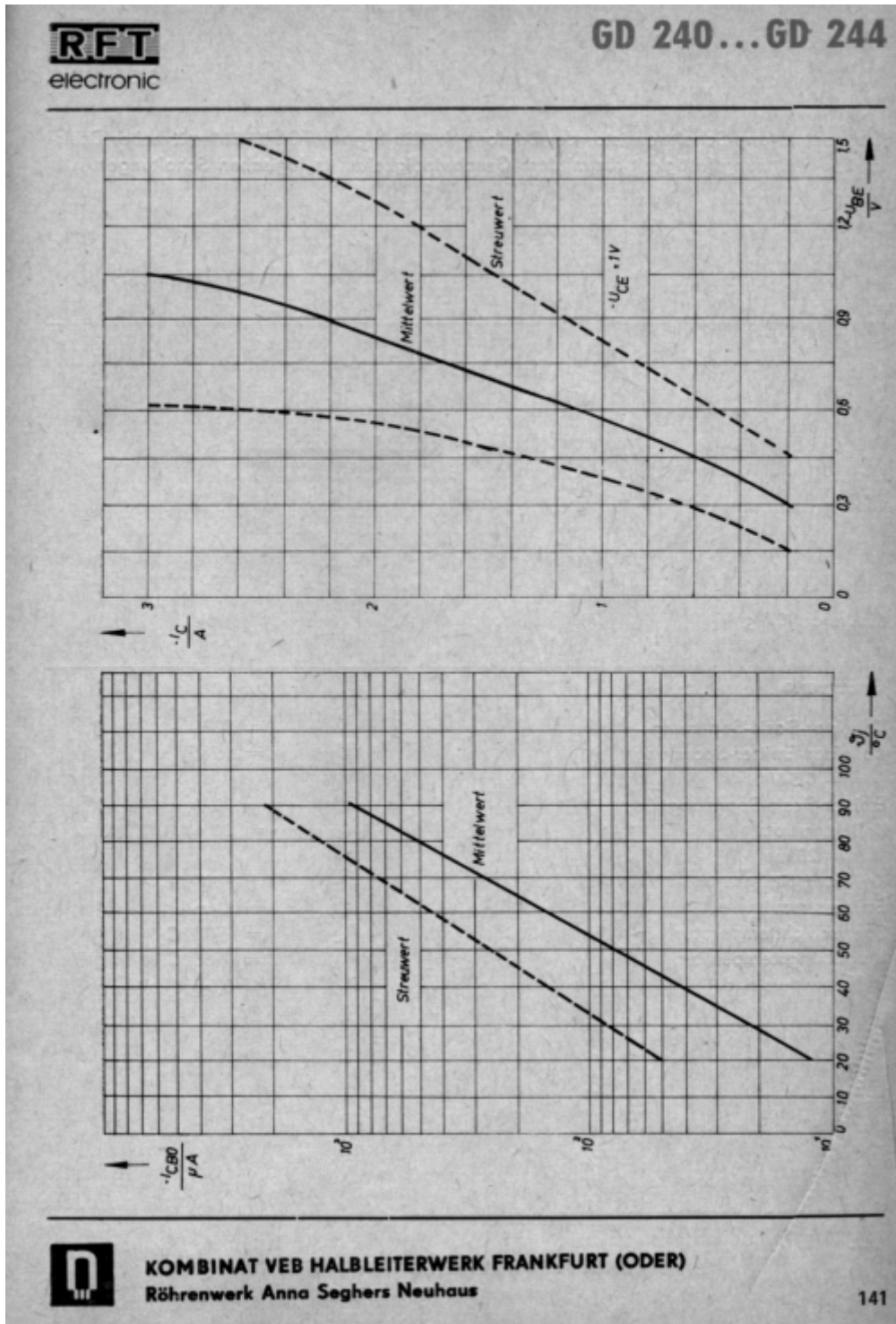


KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Röhrenwerk Anna Seghers Neuhaus

129







KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Röhrenwerk Anna Seghers Neuhaus